(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-23777

(P2001-23777A)

(43)公開日 平成13年1月26日(2001.1.26)

		# 10/45-40)
觀別記号	F I	デーマコート*(参考)
	H05B 33/14	B 3K007
640	C09K 11/06	640
6 5 5		655
	H 0 5 B 33/22	B
		D
	審查請求 未請求 蓄	水項の数11 OL (全 20 頁)
特顧平11-194617	(71)出廣人 000003159	
(21)出顧番号 特顧平11-194617	東レ株式会	社
平成11年7月8日(1999.7.8)	東京都中央	区日本福室町2丁目2番1号
(22)出願日 平成11年7月8日(1999.7.8)	(72)発明者 富永 剛	
		市園山1丁目1番1号 東レ株
		••••
		, は市関山1丁目1番1号 東レ株
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		市閩山1丁目1番1号 東レ株
	式会社遊費	[事業場内
	Fターム(参考) 3K007	AB02 AB03 AB04 BA06 CA01
	27 (2	CB01 DA00 DB03 EB00 FA01
	6 5 5	日

(54) 【発明の名称】 発光素子

(57)【要約】

【課題】発光効率が高く、高輝度で色純度に優れた発光 素子を提供する。

【解決手段】陽極と陰極の間に発光を司る物質が存在 し、電気エネルギーにより発光する素子において、該素 子がフェナンスロアゾール骨格を有する化合物を含むこ とを特徴とする発光素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】陽極と陰極の間に発光を司る物質が存在 し、電気エネルギーにより発光する素子において、該素 子がフェナンスロアゾール骨格を有する化合物を含むこ とを特徴とする発光素子。

【請求項2】フェナンスロアゾール骨格を有する化合物が下記一般式(1)で表されることを特徴とする請求項1記載の発光素子。

【化1】。

$$\begin{array}{c|c}
R_3 \\
R_6 \\
R_6 \\
R_7 \\
R_8
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_2 \\
R_1 \\
R_1 \\
R_1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
(1) \\
R_7 \\
R_8
\end{array}$$

(ここでR1~R9はそれぞれ同じでも異なっていてもよ 20 く、結合、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。Z1は酸素、硫黄、置換もしくは無置換の飽和炭化水素のいずれかより選ばれる。置換基はR1~R9と 30 同様である。)

【請求項3】フェナンスロアゾール骨格を有する化合物が下記一般式(2)で表されることを特徴とする請求項1記載の発光素子。

【化2】

$$R_{12}$$
 R_{10}
 R_{13}
 R_{14}
 R_{15}
 R_{16}
 R_{17}
 R_{18}
 R_{19}
 R_{19}

(ここでR10~R17はそれぞれ同じでも異なっていても よく、結合、水素、アルキル基、シクロアルキル基、ア ラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アル コキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。 Zzは酸素、硫黄、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の飽和炭化水素のいずれかよ

型系、直接もしくは無直接の最初板化水系のいりなかる り選ばれる。Aは共役結合、置換もしくは無置換の芳香 10 環、置換もしくは無置換の複素環あるいはこれらを混合 した基のいずれかより選ばれる。置換基はR₁0~R₁7と 同様である。)

【請求項4】フェナンスロアゾール骨格を複数個有する 化合物を含むことを特徴とする請求項1記載の発光素 子。

【請求項5】フェナンスロアゾール骨格を有する化合物が下記一般式(3)で表されることを特徴とする請求項4記載の発光素子。

【化3】

$$\begin{bmatrix}
R_{20} & & & & \\
R_{21} & & & & \\
R_{22} & & & & \\
R_{23} & & & & \\
R_{24} & & & & \\
R_{25} & & & & \\
R_{26} & & & & \\
R_{26} & & & & \\
R_{27} & & & & \\
R_{28} & & & & \\
R_{28} & & & & \\
R_{29} & & & & \\
R_{20} & & & \\
R_{20} & & &$$

(ここでR18~R25はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。Z3は酸素、硫黄、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、

40 置換もしくは無置換の飽和炭化水素のいずれかより選ばれる。置換基はR18~R25と同様である。nは2以上の整数であり、X1は複数のフェナンスロアゾール骨格を共役的または非共役的に互いに結合させる結合単位である。)

【請求項6】フェナンスロアゾール骨格を有する化合物が下記一般式(4)で表されることを特徴とする請求項4記載の発光素子。

【化4】

(ここでR26~R34はそれぞれ同じでも異なっていても ル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキシ 基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチ オエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、ハロ アルカン、ハロアルケン、シアノ基、アルデヒド基、カ ルボニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイ ル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル 基、隣接置換基との間に形成される環構造の中から選ば れる。nは2以上の整数であり、X2は複数のフェナン スロアゾール骨格を共役的または非共役的に互いに結合 させる結合単位である。)

【請求項7】一般式(3)のX1で示した結合単位、一 般式(4)のX2で示した結合単位およびR26が少なく とも共役結合、置換もしくは無置換の芳香環、置換もし くは無置換の複素環あるいはこれらを混合した基のいず れかより選ばれることを特徴とする請求項5または6記 載の発光素子。

【請求項8】前記化合物が発光材料であることを特徴と する請求項1記載の発光素子。

【請求項9】前記化合物が正孔輸送材料であることを特 徴とする請求項1記載の発光素子。

【請求項10】前記化合物が電子輸送材料であることを 特徴とする請求項1記載の発光素子。

【請求項11】発光素子がマトリクスおよび/またはセ グメント方式によって表示するディスプレイを構成する ことを特徴とする請求項1~10のいずれか記載の発光 素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 光に変換できる素子であって、表示素子、フラットパネ 40 ルディスプレイ、バックライト、照明、インテリア、標 識、看板、電子写真機、光信号発生器などの分野に利用 可能な発光素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】陰極から注入された電子と陽極から注入 された正孔が両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合する 際に発光するという有機積層薄膜発光素子の研究が近年 活発に行われている。この素子は、薄型、低駆動電圧下 での高輝度発光、蛍光材料を選ぶことによる多色発光が 特徴であり注目を集めている。

*【0003】この研究は、コダック社のC. W. Tan よく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキ 10 gらが有機積層薄膜素子が高輝度に発光することを示し て以来(Appl. Phys. Lett. 51(12) 21, p. 913, 1987) 、多くの研究機関が検討 を行っている。コダック社の研究グループが提示した有 機積層薄膜発光素子の代表的な構成は、ITOガラス基 板上に正孔輪送性のジアミン化合物、発光層である8-ヒドロキシキノリンアルミニウム、そして陰極としてM g:Agを順次設けたものであり、10V程度の駆動電 圧で1000cd/m²の緑色発光が可能であった。現 在の有機積層薄膜発光素子は、上記の素子構成要素の他 20 に電子輸送層を設けているものなど構成を変えているも のもあるが、基本的にはコダック社の構成を踏襲してい

> 【0004】発光層はホスト材料のみや、ホスト材料に ゲスト材料をドーピングして構成される。三原色の発光 材料の中では緑色発光材料の研究が最も進んでおり、現 在は赤色発光材料と青色発光材料において、特性向上を・ 目指して鋭意研究がなされている。特に青色発光におい て、耐久性に優れ十分な輝度と色純度特性を示すものが 望まれている。

【0005】ホスト材料としては、トリス(8-キノリ 30 ノラト) アルミニウムを始めとするキノリノール誘導体 の金属錯体、ベンゾキノリノールの金属錯体、ベンズオ キサゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、チアジア ゾール誘導体、チオフェン誘導体などがあげられる。 【0006】青色発光用のホスト材料としては、キノリ ノール誘導体と異なる配位子を組み合わせた金属錯体、 ビススチリルベンゼン誘導体、スターバースト型ベンズ アゾール誘導体 (特開平10-92578号公報) など があげられ、比較的良い特性を示すが、特に色純度、熱 的・化学的安定性が十分ではない。

【0007】一方、ゲスト材料としてのドーパント材料 には、レーザー染料として有用であることが知られてい る、7-ジメチルアミノ-4-メチルクマリンを始めと する蛍光性クマリン染料、ジシアノメチレンピラン染 料、ジシアノメチレンチオピラン染料、ポリメチン染 料、シアニン染料、オキソベンズアンスラセン染料、キ サンテン染料、ローダミン染料、フルオレセイン染料、 ピリリウム染料、カルボスチリル染料、ペリレン染料、 アクリジン染料、ビス (スチリル) ベンゼン染料、ピレ *50 ン染料、オキサジン染料、フェニレンオキサイド染料、

ペリレン、テトラセン、ペンタセン、キナクリドン化合 物、キナゾリン化合物、ピロロピリジン化合物、フロピ リジン化合物、1、2、5-チアジアゾロピレン誘導 体、ペリノン誘導体、ピロロピロール化合物、スクアリ リウム化合物、ビオラントロン化合物、フェナジン誘導 体、アクリドン化合物、ジアザフラビン誘導体などが知 られている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来技術に用 いられる発光材料(ホスト材料、ドーパント材料)に は、発光効率が低く消費電力が高いものや、化合物の耐 久性が低く素子寿命の短いものが多かった。また、フル カラーディスプレイとして赤色、緑色、青色の三原色発 光が求められているが、赤色、青色発光においては、発 光波長を満足させるものは少なく、発光ピークの幅も広 く色純度が良いものは少ない。中でも青色発光におい て、耐久性に優れ十分な輝度と色純度特性を示すものが 必要とされている。

【0009】本発明は、かかる従来技術の問題を解決 し、発光効率が高く、高輝度で色純度に優れた発光素子 20 を提供することを目的とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、陽極と陰極の 間に発光を司る物質が存在し、電気エネルギーにより発 光する素子において、該素子がフェナンスロアゾール骨 格を有する化合物を含むことを特徴とする発光素子であ る。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明において陽極は、光を取り 出すために透明であれば酸化錫、酸化インジウム、酸化 30 錫インジウム (ITO) などの導電性金属酸化物、ある いは金、銀、クロムなどの金属、ヨウ化銅、硫化銅など の無機導電性物質、ポリチオフェン、ポリピロール、ポ リアニリンなどの導電性ポリマなど特に限定されるもの でないが、ITOガラスやネサガラスを用いることが特 に望ましい。透明電極の抵抗は素子の発光に十分な電流 が供給できればよいので限定されないが、素子の消費電 力の観点からは低抵抗であることが望ましい。例えば3 00Ω/□以下のITO基板であれば素子電極として機 能するが、現在では100/□程度の基板の供給も可能 になっていることから、低抵抗品を使用することが特に 望ましい。ITOの厚みは抵抗値に合わせて任意に選ぶ 事ができるが、通常100~300mmの間で用いられ ることが多い。また、ガラス基板はソーダライムガラ ス、無アルカリガラスなどが用いられ、また厚みも機械 的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、0.5 mm以上あれば十分である。ガラスの材質については、 ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無アルカ リガラスの方が好ましいが、SiOz などのバリアコー

れを使用できる。ITO膜形成方法は、電子線ビーム 法、スパッタリング法、化学反応法など特に制限を受け るものではない。

【0012】陰極は、電子を本有機物層に効率良く注入 できる物質であれば特に限定されないが、一般に白金、 金、銀、銅、鉄、錫、亜鉛、アルミニウム、インジウ ム、クロム、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシ ウム、マグネシウムなどがあげられるが、電子注入効率 をあげて素子特性を向上させるためにはリチウム、ナト リウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムまたはこ れら低仕事関数金属を含む合金が有効である。しかし、 これらの低仕事関数金属は、一般に大気中で不安定であ ることが多く、例えば、有機層に微量のリチウムやマグ ネシウム (真空蒸着の膜厚計表示で1 nm以下)をドー ピングして安定性の高い電極を使用する方法が好ましい 例として挙げることができるが、フッ化リチウムのよう な無機塩の使用も可能であることから特にこれらに限定 されるものではない。更に電極保護のために白金、金、 銀、銅、鉄、錫、アルミニウム、インジウムなどの金 属、またはこれら金属を用いた合金、そしてシリカ、チ タニア、窒化ケイ素などの無機物、ポリビニルアルコー ル、塩化ビニル、炭化水素系高分子などを積層すること が好ましい例として挙げられる。これらの電極の作製法 も抵抗加熱、電子線ビーム、スパッタリング、イオンプ レーティング、コーティングなど導通を取ることができ れば特に制限されない。

【0013】発光を司る物質とは、1)正孔輸送層/発 光層、2)正孔輸送層/発光層/電子輸送層、3)発光 層/電子輸送層、そして、4)以上の組合わせ物質を一 層に混合した形態のいずれであってもよい。即ち、素子 構成としては、上記1)~3)の多層積層構造の他に 4) のように発光材料単独または発光材料と正孔輸送材 料や電子輸送材料を含む層を一層設けるだけでもよい。 【0014】正孔輸送層は正孔輸送性物質単独または二 種類以上の物質を積層、混合するか正孔輸送性物質と高 分子結着剤の混合物により形成され、正孔輸送性物質と してはTPD、m-MTDATA、α-NPDなどのト リフェニルアミン類、ビス (N-アリルカルバゾール) またはビス (N-アルキルカルバゾール) 類、 ピラゾリ ン誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、 オキサジアゾール誘導体やフタロシアニン誘導体、ポル フィリン誘導体に代表される複素環化合物、ポリマー系 では前記単量体を側鎖に有するポリカーボネートやスチ レン誘導体、ポリビニルカルバゾール、ポリシランなど が好ましいが、素子作製に必要な薄膜を形成し、陽極か ら正孔が注入できて、さらに正孔を輸送できる化合物で あれば特に限定されるものではない。また、本発明にお けるフェナンスロアゾール骨格を有する化合物も修飾す る置換基により、正孔輸送能を付与することができるの トを施したソーダライムガラスも市販されているのでこ 50 で、前記化合物を正孔輸送材料としても好ましく用いる

ことができる。

【0015】本発明における発光材料はホスト材料のみ でも、ホスト材料とドーパント材料の組み合わせでも、 いずれであってもよい。また、ドーパント材料はホスト 材料の全体に含まれていても、部分的に含まれていて も、いずれであってもよい。ドーパント材料は積層され ていても、分散されていても、いずれであってもよい。 【0016】本発明においては、発光材料はフェナンス ロアゾール骨格を有する化合物を含有することを特徴と している。フェナンスロアゾール骨格を有する化合物の 10 中でも下記一般式(1)化合物が好ましい。

[0017]

【化5】

【0018】(ここでR1~R9はそれぞれ同じでも異な っていてもよく、結合、水素、アルキル基、シクロアル キル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニ ル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテ ル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環 基、ハロゲン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル 基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイル基、ア 30 かまわない。アルデヒド基、カルボニル基、エステル ミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル基、隣接置 換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。Z1 は酸素、硫黄、置換もしくは無置換の窒素、置換もしく は無置換の飽和炭化水素のいずれかより選ばれる。置換 基はR1~R9と同様である。)

これらの置換基のうち、結合とはその位置で複数個のフ ェナンスロアゾール骨格と連結されていることを意味す る。この場合、複数個のフェナンスロアゾールは直接連 結されていても構わないし、ある結合単位を介して連結 されていても構わない。アルキル基とは例えばメチル 基、エチル基、プロビル基、ブチル基などの飽和脂肪族 炭化水素基を示し、これは無置換でも置換されていても かまわない。また、シクロアルキル基とは例えばシクロ プロピル、シクロヘキシル、ノルボルニル、アダマンチ ルなどの飽和脂環式炭化水素基を示し、これは無置換で も置換されていてもかまわない。また、アラルキル基と は例えばベンジル基、フェニルエチル基などの脂肪族炭 化水素を介した芳香族炭化水素基を示し、脂肪族炭化水 素と芳香族炭化水素はいずれも無置換でも置換されてい てもかまわない。また、アルケニル基とは例えばビニル 50

基、アリル基、ブタジエニル基などの二重結合を含む不 飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換でも置換さ れていてもかまわない。また、シクロアルケニル基とは 例えばシクロペンテニル基、シクロペンタジエニル基、 シクロヘキセン基などの二重結合を含む不飽和脂環式炭 化水素基を示し、これは無置換でも置換されていてもか まわない。また、アルコキシ基とは例えばメトキシ基な どのエーテル結合を介した脂肪族炭化水素基を示し、脂 肪族炭化水素基は無置換でも置換されていてもかまわな い。また、アルキルチオ基とはアルコキシ基のエーテル 結合の酸素原子が硫黄原子に置換されたものである。ま た、アリールエーテル基とは例えばフェノキシ基などの エーテル結合を介した芳香族炭化水素基を示し、芳香族 炭化水素基は無置換でも置換されていてもかまわない。 また、アリールチオエーテル基とはアリールエーテル基 のエーテル結合の酸素原子が硫黄原子に置換されたもの である。また、アリール基とは例えばフェニル基、ナフ チル基、ビフェニル基、フェナントリル基、ターフェニ ル基、ピレニル基などの芳香族炭化水素基を示し、これ 20 は無置換でも置換されていてもかまわない。また、複素 環基とは例えばフリル基、チエニル基、オキサゾリル 基、ピリジル基、キノリル基、カルバゾリル基などの炭 素以外の原子を有する環状構造基を示し、これは無置換 でも置換されていてもかまわない。ハロゲンとはフッ 素、塩素、臭素、ヨウ素を示す。ハロアルカン、ハロア ルケン、ハロアルキンとは例えばトリフルオロメチル基 などの、前述のアルキル基、アルケニル基、アルキニル 基の一部あるいは全部が、前述のハロゲンで置換された ものを示し、残りの部分は無置換でも置換されていても 基、カルバモイル基、アミノ基には脂肪族炭化水素、脂 環式炭化水素、芳香族炭化水素、複素環などで置換され たものも含み、さらに脂肪族炭化水素、脂環式炭化水 素、芳香族炭化水素、複素環は無置換でも置換されてい てもかまわない。シリル基とは例えばトリメチルシリル 基などのケイ素化合物基を示し、これは無置換でも置換 されていてもかまわない。シロキサニル基とは例えばト リメチルシロキサニル基などのエーテル結合を介したケ イ素化合物基を示し、これは無置換でも置換されていて もかまわない。隣接置換基との間に形成される環構造は 無置換でも置換されていてもかまわない。

【0019】本発明における一般式(1)のフェナンス ロアゾール骨格を有する化合物の中では、適当なピーク 波長の青色蛍光が得られ、発光ホスト材料として用いる 場合はキャリヤ輸送能が向上することから下記一般式 (2)で示される化合物が好適に用いられる。

[0020]

【化6】

*一般式(3)または一般式(4)で表される化合物がよ

$$R_{12}$$
 R_{10}
 R_{13}
 R_{14}
 R_{15}
 R_{17}
 R_{17}
 R_{17}
 R_{18}
 R_{19}
 R_{19}

【0021】(ここでR10~R17はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、結合、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アリールキオ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。 Z2は酸素、硫黄、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の資素、置換もしくは無置換の方香環、置換もしくは無置換の方香環、置換もしくは無置換の方香環、置換もしくは無置換の方香環、置換もしくは無置換の方香環、置換もしくは無置換の表環あるいはこれらを混合した基のいずれかから選ばれる。置換基はR10~R17と同様である。)

これらの置換基の説明については、上述したものと同様 である。

【0022】また、フェナンスロアゾール骨格を有する 化合物の中では、熱的安定性が得られることからフェナ ンスロアゾール骨格を複数個有する化合物が好ましく、 分子を分岐状に修飾することが容易であることから下記*

【0024】(ここでR18~R25はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アリーキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、20 ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。Z3は酸素、硫黄、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の窒素、置換もしくは無置換の節和炭化水素のいずれかより選ばれる。置換基はR18~R25と同様である。nは2以上の整数であり、X1は複数のフェナンスロアゾール骨格を共役的または非共役的に互いに結合させる結合単位である。)

[0025]

【化8】

【0026】(ここでR26~R34はそれぞれ同じでも異 40をっていてもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。nは2以上の整数であり、X2は複数のフェナンスロアゾール骨格を共役的または非共役的※50

40%に互いに結合させる結合単位である。)

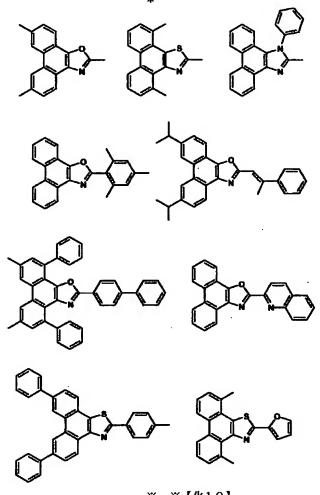
これらの置換基のうち、R18~R25およびR26~R34に 関しては上述したものと同様である。結合単位であるX 1、X2は結合部位を示すが、具体的には単結合、二重結 合、アルキル、シクロアルキル、アリール、複素環、エ ーテルあるいはチオエーテルが挙げられるがこれらに限 定されるものではない。これらは無置換でも置換されて いてもかまわないし、さらにこれらを単独あるいは組み 合わせて用いてもかまわない。

【0027】さらに、本発明における化合物を特にホスト材料として用いて、高輝度発光を得るには、キャリヤ

輸送能が高い化合物を用いるのが好ましい。そこで、前記フェナンスロアゾール骨格を複数個有する化合物としては、結合単位中あるいは2位の位置に共役結合、置換もしくは無置換の複素環あるいはこれらを混合した基のいずれかから選ばれているものがより好ましい。

*【0028】上記のフェナンスロアゾール骨格を有する 化合物として、具体的には下記のような構造があげられ る。

【0029】 【化9】



[0030]

※ ※【化10】

[0031]

[0032]

*【化12】

[0033]

【0034】 【化14】

【0035】 【化15】

10

26

[0038]

* * 【化18】

【0039】フェナンスロアゾール骨格を有する化合物 はドーパント材料として用いてもホスト材料として用い 30 できる。 てもかまわない。

【0040】発光材料のホスト材料はフェナンスロアゾ ール骨格を有する化合物一種のみに限る必要はなく、複 数の前記化合物を混合して用いたり、既知のホスト材料 の一種類以上を前記化合物と混合して用いてもよい。既 知のホスト材料としては特に限定されるものではない が、以前から発光体として知られていたフェナンスレ ン、ピレン、ペリレン、クリセンなどの縮合環誘導体、 トリス (8-キノリノラト) アルミニウムを始めとする キノリノール誘導体の金属錯体、ベンズアゾール誘導体 およびその金属錯体、キノリノール誘導体と異なる配位 子を組み合わせた金属錯体、オキサジアゾール誘導体お よびその金属錯体、チアジアゾール誘導体、スチルベン 誘導体、チオフェン誘導体、テトラフェニルブタジエン 誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ビススチリルアン トラセン誘導体やジスチリルベンゼン誘導体などのビス スチリル誘導体、クマリン誘導体、ピロロピリジン誘導 体、ピロロピロール誘導体、ペリノン誘導体、チアジア ゾロビリジン誘導体、ポリマー系では、ポリフェニレン ビニレン誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポリフル*50 ラン誘導体、ジベンゾフラン誘導体、7-ジアルキルア

*オレン誘導体そして、ポリチオフェン誘導体などが使用

【0041】発光材料に添加するドーパント材料は、特 に限定されるものではないが、フェナンスロアゾール骨 格を有する化合物以外の具体的なものとしては、従来か ら知られている、アントラセン、ピレン、テトラセン、 ペンタセン、ペリレン、ナフトピレン、ジベンゾピレン などの縮合環誘導体、アゾール誘導体およびその金属錯 体、トリアゾール誘導体およびその金属錯体、ベンズア ゾール誘導体及びその金属錯体、ベンズトリアゾール誘 導体およびその金属錯体、オキサジアゾール誘導体およ びその金属錯体、チアジアゾール誘導体およびその金属 錯体、ピラゾリン誘導体、スチルベン誘導体、チオフェ ン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、シクロペ ンタジエン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導体や ジスチリルベンゼン誘導体などのビススチリル誘導体、 ジアザインダセン誘導体、フラン誘導体、ベンゾフラン 誘導体、フェニルイソベンゾフラン、ジメシチルイソベ ンゾフラン、ジ (2-メチルフェニル) イソベンゾフラ ン、ジ(2-トリフルオロメチルフェニル) イソベンゾ フラン、フェニルイソベンゾフランなどのイソベンゾフ

ル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂 などの硬化性樹脂などに分散させて用いることも可能で

30

ミノクマリン誘導体、7-ピペリジノクマリン誘導体、 7-ヒドロキシクマリン誘導体、7-メトキシクマリン 誘導体、7-アセトキシクマリン誘導体、3-ベンズチ アゾリルクマリン誘導体、3ーベンズイミダゾリルクマ リン誘導体、3-ベンズオキサゾリルクマリン誘導体な どのクマリン誘導体、ジシアノメチレンピラン誘導体、 ジシアノメチレンチオピラン誘導体、ポリメチン誘導 体、シアニン誘導体、オキソベンズアンスラセン誘導 体、キサンテン誘導体、ローダミン誘導体、フルオレセ イン誘導体、ピリリウム誘導体、カルボスチリル誘導 体、アクリジン誘導体、ビス(スチリル)ベンゼン誘導 体、オキサジン誘導体、フェニレンオキサイド誘導体、 キナクリドン誘導体、キナゾリン誘導体、ピロロピリジ ン誘導体、フロビリジン誘導体、1,2,5ーチアジア ゾロピレン誘導体、ペリノン誘導体、ピロロピロール誘 導体、スクアリリウム誘導体、ビオラントロン誘導体、 フェナジン誘導体、アクリドン誘導体、ジアザフラビン 誘導体などがそのまま使用できるが、特にイソベンゾフ ラン誘導体が好適に用いられる。

【0042】本発明における電子輸送性材料としては、 電界を与えられた電極間において負極からの電子を効率 良く輸送することが必要で、電子注入効率が高く、注入 された電子を効率良く輸送することが望ましい。そのた めには電子親和力が大きく、しかも電子移動度が大き く、さらに安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造 時および使用時に発生しにくい物質であることが要求さ れる。このような条件を満たす物質として、8-ヒドロ キシキノリンアルミニウムに代表されるキノリノール誘 導体金属錯体、トロポロン金属錯体、フラボノール金属 錯体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、ナフタレン、 30 クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン 誘導体、ビススチリル誘導体、ピラジン誘導体、フェナ ントロリン誘導体などがあるが特に限定されるものでは ない。本発明におけるフェナンスロアゾール骨格を有す る化合物も置換基の種類によっては電子輸送能を付与す ることができることから、前記化合物を電子輸送材料と しても好ましく用いることができる。これらの電子輸送 材料は単独でも用いられるが、異なる電子輸送材料と積 層または混合して使用しても構わない。

【0043】以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層に 40 用いられる材料は単独で各層を形成することができる が、高分子結着剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネ ート、ポリスチレン、ポリ(N-ビニルカルバゾー ル)、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリ レート、ポリエステル、ポリスルフォン、ポリフェニレ ンオキサイド、ポリブタジエン、炭化水素樹脂、ケトン 樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロー ス、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン樹脂などの 溶剤可溶性樹脂や、フェノール樹脂、キシレン樹脂、石

【0044】本発明における発光を司る物質の形成方法 は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング 法、分子積層法、コーティング法など特に限定されるも のではないが、通常は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着 が特性面で好ましい。層の厚みは発光を司る物質の抵抗 値にもよるので限定できないが、10~1000 nmの 10 間から選ばれる。

【0045】本発明における電気エネルギーとは主に直 流電流を指すが、パルス電流や交流電流を用いることも 可能である。電流値および電圧値は特に制限はないが、 素子の消費電力、寿命を考慮すると、できるだけ低い工 ネルギーで最大の輝度が得られるようにするべきであ

【0046】本発明の発光素子はマトリクスまたはセグ メント方式、あるいはその両者を組み合わせることによ って表示するディスプレイを構成することが好ましい。 本発明におけるマトリクスとは、表示のための画素が格 子状に配置されたものをいい、画素の集合で文字や画像 を表示する。画素の形状、サイズは用途によって決ま る。例えばパソコン、モニター、テレビの画像および文 字表示には、通常、一辺が300μm以下の四角形の画 素が用いられるし、表示パネルのような大型ディスプレ イの場合は、一辺がmmオーダーの画素を用いることに なる。モノクロ表示の場合は、同じ色の画素を配列すれ ばよいが、カラー表示の場合には赤、緑、青の画素を並 べて表示させる。この場合典型的にはデルタタイプとス トライプタイプがある。尚、本発明における発光素子 は、赤、緑、青色発光が可能であるので、前記表示方法 を用いれば、マルチカラーまたはフルカラー表示もでき る。そして、このマトリクスの駆動方法としては、線順 次駆動方法やアクティブマトリックスのどちらでもよ い。線順次駆動の方が構造が簡単という利点があるが、 動作特性を考慮するとアクティブマトリックスの方が優 れる場合があるので、これも用途により使い分けること が必要である。

【0047】また、本発明におけるセグメントタイプと は、予め決められた情報を表示するようにパターンを形 成し、決められた領域を発光させることを意味する。例 えば、デジタル時計や温度計における時刻や温度表示、 オーディオ機器や電磁調理器などの動作状態表示、自動 車のパネル表示などがあげられる。そして、前記マトリ クス表示とセグメント表示は同じパネルの中に共存して いてもよい。

【0048】本発明の発光素子はバックライトとしても 好ましく用いられる。バックライトは、主に自発光しな い表示装置の視認性を向上させる目的に使用され、液晶 油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステ 50 表示装置、時計、オーディオ装置、自動車パネル、表示

板、標識などに使用される。特に液晶表示装置、中でも 薄型化が課題となっているパソコン用途のバックライト としては、従来方式のものが蛍光灯や導光板からなって いるため薄型化が困難であることを考えると、本発明に おける発光素子を用いたバックライトは薄型、軽量が特 徴になる。

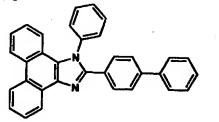
[0049]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも のではない。なお、CIE色度座標について、x、yの 10 各々0.2以下の数値は、高色純度の青色であることを 示している。

【0050】実施例1

ITO透明導電膜を150nm堆積させたガラス基板 (旭硝子社製、150/□、電子ビーム蒸着品)を30 ×40mmに切断、エッチングを行った。得られた基板 をアセトン、セミコクリン56で各々15分間超音波洗 浄してから、超純水で洗浄した。続いてイソプロピルア ルコールで15分間超音波洗浄してから熱メタノールに 15分間浸漬させて乾燥させた。この基板を素子を作製 20 する直前に1時間UV-オゾン処理し、真空蒸着装置内 に設置して、装置内の真空度が5×10-5 Pa以下にな るまで排気した。抵抗加熱法によって、まず正孔輸送材 料として4、4'ーピス(N-(m-トリル)-N-フ ェニルアミノ) ピフェニル (TPD) を50 nm蒸着し た。次に発光材料として、下記に示されるEM1を15 nmの厚さに積層した。次に電子輸送材料として、2, 9-ジメチルー4, 7-ジフェニルー1, 10-フェナ ントロリンを35 nmの厚さに積層し、引き続き金属リ チウムを微量ドーピングした(膜厚換算0.5nm)。 最後に、銀を150nm蒸着して陰極とし、5×5mm 角の素子を作製した。ここで言う膜厚は表面祖さ計での 測定値で補正した水晶発振式膜厚モニター表示値であ 3.

【0051】 【化19】



32

【0052】実施例2

発光材料として下記に示されるEM2を用いた他は実施 例1と全く同様にして発光素子を作製した。

[0053]

【0054】実施例3

発光材料として下記に示されるEM3を用いた他は実施 例1と全く同様にして発光素子を作製した。

[0055]

0 【化21】

【0056】実施例4

発光材料として下記に示されるEM4を用いた他は実施 例1と全く同様にして発光素子を作製した。

[0057]

【化22】

【0058】実施例5

発光層部分をホスト材料として下記に示されるEM5 を、ドーパント材料として1,3-ジ(2-メチルフェ ニル) イソベンゾフランを用いて、ドーパントが0.5 wt%になるように15nmの厚さに共蒸着した以外は 実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。

[0059]

【化23】

EM5

【0060】実施例6

発光層部分をホスト材料としてEM1を、ドーパント材 30 料として1,3-ジメシチルイソベンゾフランを用い て、ドーパントが1wt%になるように15nmの厚さ に共蒸着した以外は実施例1と全く同様にして発光素子 を作製した。

【0061】実施例7

正孔輸送材料としてEM2を発光材料としてEM3を用 いた他は実施例1と全く同様にして発光素子を作製し た。

【0062】実施例8

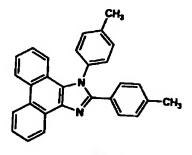
発光材料としてEM5を用いた他は実施例1と全く同様 40 にして発光素子を作製した。

【0063】実施例9

発光材料として下記に示されるEM6を用いた他は実施 例1と全く同様にして発光素子を作製した。

[0064]

【化24】



EM6

【0065】実施例10

発光材料として下記に示されるEM7を用いた他は実施 例1と全く同様にして発光素子を作製した。

[0066]

【化25】

EM7

【0067】実施例11

発光材料として下記に示されるEM8を用いた他は実施 例1と全く同様にして発光素子を作製した。

[0068]

【化26】

発光材料として下記に示されるEM9を用いた他は実施 例1と全く同様にして発光素子を作製した。

[0070]

【化27】

【0071】実施例13

発光材料として下記に示されるEM10を用いた他は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。

[0072]

【化28】

EM10

【0073】これらの結果を表1、表2に示した。良好な背色発光が得られた。

[0074]

【表1】 表1

		色度座標	
	ピーク波長(mp)	×	y
実施例 1	4 4 5	0. 15	0. 11
実施例2	442	0. 17	0. 15
実施例3	465	0. 16	0. 15
実施例 4	4 4 1	0. 16	0.13
実施例 5	467	0. 16	0.18
実施例 6	453	0.16	0. 14
実施例7	4 5 8	0. 16	0. 17
実施例8	4 3 0	0. 15	0.09
実施例 9	4 2 6	0. 15	0.07
実施例10	4 3 0	0. 19	0.19
実施例11	4 2 7	0.16	0.08
実施例12	4 2 5	0.17	0. 15
実施例13	4 3 1	0. 17	0. 12

[0075]

【表2】	
	表

輝度(cd/m²)		
-54-64		
実施例1	1047	
実施例2	1400	
実施例3	2740	
実施例4	1355	
実施例5	2240	
実施例6	2250	
実施例7	2670	

36

0 【0076】比較例1

発光材料として実施例1で用いたEM1の代わりにビス (2-メチルキノリノラート) (2-ピリジノラート) アルミニウム (III) を用いた以外は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。この発光素子からは、輝度は1000カンデラ/平方メートル(cd/m²)以上の発光が得られたが、ビーク波長は510nmの青緑色発光しか得られなかった。

【0077】比較例2

ホスト材料としてビス(2-メチルキノリノラート)
20 (2-ビリジノラート)アルミニウム(III)を用いた 以外は実施例6と全く同様にして発光素子を作製した。 この発光素子からは、輝度は1000cd/m²以上の 発光が得られたが、ピーク波長:510nmの青緑色発 光しか得られなかった。

【0078】実施例14

ITO透明導電膜を150nm堆積させたガラス基板 (旭硝子社製、15Ω/□、電子ビーム蒸着品)を30 ×40mmに切断、フォトリソグラフィ法によって30 $0\mu m$ ピッチ (残り幅270 μm) ×32本のストライ 30 プ状にパターン加工した。ITOストライプの長辺方向 片側は外部との電気的接続を容易にするために1.27 mmピッチ (開口部幅800µm) まで広げてある。得 られた基板をアセトン、セミコクリン56で各々15分 間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。続いてイソ プロピルアルコールで15分間超音波洗浄してから熱メ タノールに15分間浸漬させて乾燥させた。この基板を 素子を作製する直前に1時間UV−オゾン処理し、真空 蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が5×10-4P a以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、まず 40 正孔輸送層として、TPDを50mm蒸着し、発光層と して、実施例1で用いたEM1を15nmの厚さに、そ して電子輸送層として、2、9ージメチルー4、7ージ フェニルー1,10-フェナントロリンを35 nmの厚 さに蒸着した。ここで言う膜厚は表面粗さ計での測定値 で補正した水晶発振式膜厚モニター表示値である。次に 厚さ50μmのコバール板にウエットエッチングによっ て16本の250μmの開口部 (残り幅50μm、30 Oμmピッチに相当)を設けたマスクを、真空中で I T Oストライプに直交するようにマスク交換し、マスクと

50 I TO基板が密着するように裏面から磁石で固定した。

そして金属リチウムを微量ドーピング(膜厚換算0.5 nm)した後、アルミニウムを150nm蒸着して32×16ドットマトリクス素子を作製した。本素子をマトリクス駆動させたところ、クロストークなく文字表示できた。

[0079]

【発明の効果】本発明は、発光効率が高く、高輝度で色 純度に優れた発光素子を提供できるものである。特に背 色発光に対して有効なものである。

38